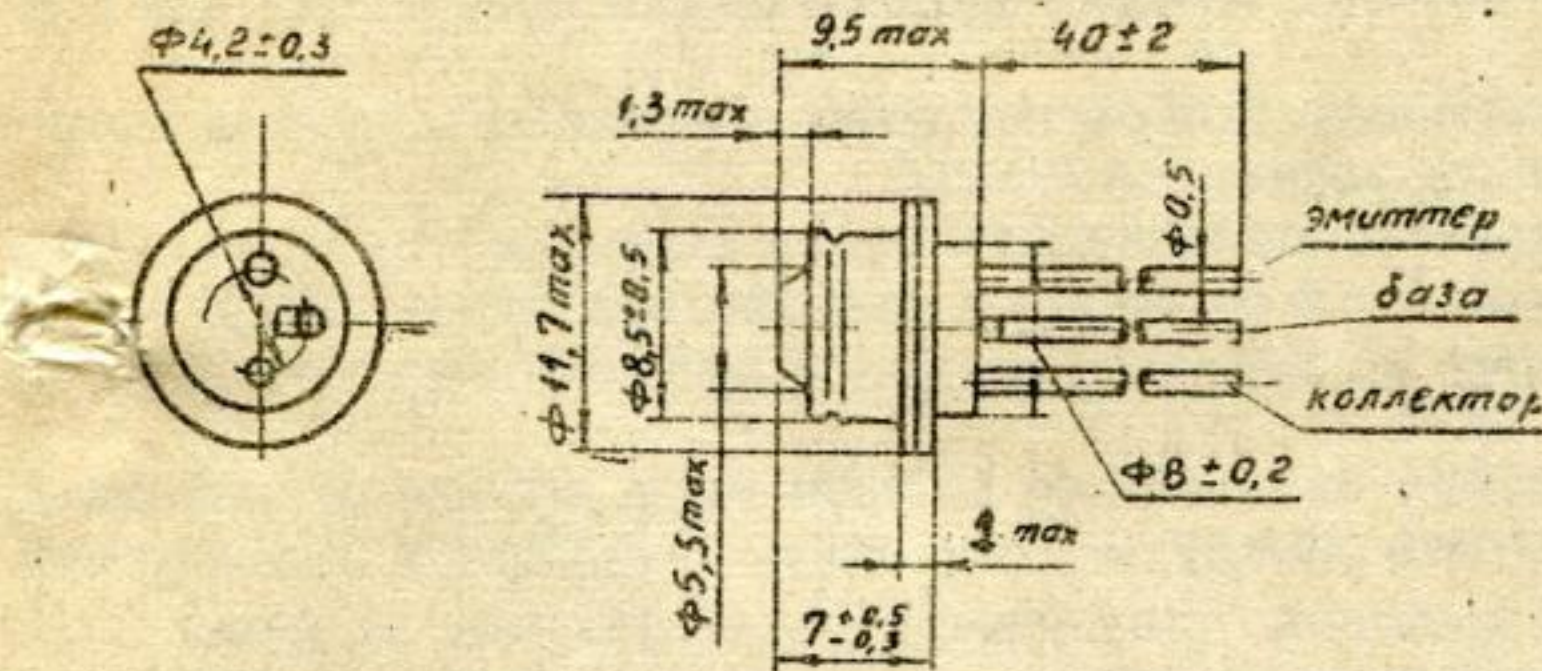


П а с п о р т

Транзистор германиевый сплавной р-п-р типа 1Т101
СБ0. 336. 013 ТУ1



Основные технические данные в схеме с общей базой
при температуре $20^{\circ} \text{C} \pm 5^{\circ} \text{C}$

Коэффициент усиления по току (в схеме с общим эмиттером) *	от 30 до 60
Выходная проводимость *	не более 2 мкмо
Предельная частота усиления по току (при напряжении коллектора минус 5 в и токе эмиттера 1 ма)	не менее 2 Мгц
Обратный ток коллектора (при напряжении коллектора минус 15 в)	не более 15 мка
Обратный ток эмиттера (при напряжении эмиттера минус 15 в)	не более 15 мка
Сопротивление базы на высокой частоте (при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера 1 ма и частоте 0,5 Мгц)	не более 250 ом
Емкость коллекторного перехода (при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера равном нулю и частоте 0,5 Мгц)	не более 50 пф

* при напряжении коллектора минус 5 в, токе эмиттера 1 ма и частоте 1000 гц.

Предельно-допустимые эксплуатационные данные

Отрицательное напряжение коллектор—база, эмиттер—база при температуре окружающей среды:

от минус 60°C до плюс 55°C не более 15 в,

от плюс 55°C до плюс 70°C не более 10 в

Отрицательное напряжение коллектор—эмиттер при температуре окружающей среды: **

от минус 60°C до плюс 55°C не более 15 в,

от плюс 55°C до плюс 70°C не более 10 в

Ток коллектора не более 10 ма

Ток эмиттера не более 10 ма

Мощность, рассеиваемая транзистором не более 50 мвт

Диапазон температур окружающей среды от минус 60°C до плюс 70°C .

** при отсутствии запирающего смещения, сопротивление в цепи эмиттер—база не должно превышать 2 ком.

Указания по эксплуатации

1. При включении транзисторов в схемы, находящиеся под напряжением, базовый вывод должен присоединяться первым.
2. Не рекомендуется располагать транзисторы вблизи нагреваемых элементов схемы.
3. Разрешается производить пайку выводов на расстоянии не менее 5 мм от корпуса транзистора путем погружения на время не более 10 секунд в припой с температурой не выше 260°C.

При пайке паяльником должен быть обеспечен надежный теплоотвод между местом пайки и корпусом транзистора.

4. Изгиб выводов допускается на расстоянии не менее 3 мм от корпуса транзистора.
5. Рекомендуется эксплуатировать транзисторы при мощности рассеивания не более $0,7P_{\text{max}}$; напряжении коллектора не более $0,7U_{\text{к max}}$ и не менее $0,3 U_{\text{к изм}}$ и при токе коллектора не более $0,9 I_{\text{к max}}$, где:

P_{max} — предельно-допустимая мощность при максимально-возможной в аппаратуре температуре;

$U_{\text{к max}}$ и $I_{\text{к max}}$ — предельно-допустимые значения напряжения и тока при данной температуре окружающей среды;

$U_{\text{к изм}}$ — напряжение, при котором измеряется коэффициент усиления.

В случае выхода транзистора из строя заполните следующие данные и отошлите поставщику.

Дата получения « » 196 г.

Дата установки « » 196 г.

Дата снятия с эксплуатации « » 196 г.

Количество отработанных часов

Краткая характеристика схемы использования

.

.

Причины снятия с эксплуатации

.

.

Наименование и адрес потребителя

.

Дата заполнения « » 196 г.

Подпись заполнявшего